

# NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER HIGH GAIN TRANSISTOR

## ZTX688B

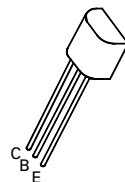
ISSUE 2 – MAY 94

### FEATURES

- \* 12 Volt  $V_{CEO}$
- \* Gain of 400 at  $I_C=3$  Amps
- \* Very low saturation voltage

### APPLICATIONS

- \* Darlington replacement
- \* Flash gun convertors
- \* Battery powered circuits
- \* Motor drivers



**E-Line**  
**T092 Compatible**

### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	$V_{CBO}$	12	V
Collector-Emitter Voltage	$V_{CEO}$	12	V
Emitter-Base Voltage	$V_{EBO}$	5	V
Peak Pulse Current	$I_{CM}$	10	A
Continuous Collector Current	$I_C$	3	A
Practical Power Dissipation*	$P_{totp}$	1.5	W
Power Dissipation at $T_{amb}=25^\circ\text{C}$ derate above $25^\circ\text{C}$	$P_{tot}$	1 5.7	W mW/ $^\circ\text{C}$
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +200	$^\circ\text{C}$

\*The power which can be dissipated assuming the device is mounted in a typical manner on a P.C.B. with copper equal to 1 inch square minimum

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$ )

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	12			V	$I_C=100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	12			V	$I_C=10\text{mA}^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	5			V	$I_E=100\mu\text{A}$
Collector Cut-Off Current	$I_{CBO}$			0.1	$\mu\text{A}$	$V_{CB}=10\text{V}$
Emitter Cut-Off Current	$I_{EBO}$			0.1	$\mu\text{A}$	$V_{EB}=4\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$			0.04 0.06 0.18 0.35	V	$I_C=0.1\text{A}, I_B=1\text{mA}$ $I_C=0.1\text{A}, I_B=0.5\text{mA}^*$ $I_C=1\text{A}, I_B=50\text{mA}^*$ $I_C=3\text{A}, I_B=20\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$			1.1	V	$I_C=3\text{A}, I_B=20\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$			1	V	$I_C=3\text{A}, V_{CE}=2\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	$h_{FE}$	500 400 100				$I_C=0.1\text{A}, V_{CE}=2\text{V}^*$ $I_C=3\text{A}, V_{CE}=2\text{V}^*$ $I_C=10\text{A}, V_{CE}=2\text{V}^*$

# ZTX688B

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ )

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Transition Frequency	$f_T$	150			MHz	$I_C=50\text{mA}$ , $V_{CE}=5\text{V}$ $f=50\text{MHz}$
Input Capacitance	$C_{ibo}$		200		pF	$V_{EB}=0.5\text{V}$ , $f=1\text{MHz}$
Output Capacitance	$C_{obo}$		40		pF	$V_{CB}=10\text{V}$ , $f=1\text{MHz}$
Switching Times	$t_{on}$ $t_{off}$		40 500		ns ns	$I_C=500\text{mA}$ , $I_{B1}=50\text{mA}$ $I_{B2}=50\text{mA}$ , $V_{CC}=10\text{V}$

\*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 $\mu\text{s}$ . Duty cycle  $\leq 2\%$

## THERMAL CHARACTERISTICS

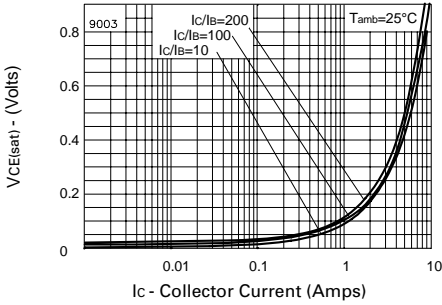
PARAMETER	SYMBOL	MAX.	UNIT
Thermal Resistance: Junction to Ambient <sub>1</sub>	$R_{th(j-amb)1}$	175	$^{\circ}\text{C/W}$
Junction to Ambient <sub>2</sub>	$R_{th(j-amb)2}$	116	$^{\circ}\text{C/W}$
Junction to Case	$R_{th(j-case)}$	70	$^{\circ}\text{C/W}$

† Device mounted on P.C.B. with copper equal to 1 sq. Inch minimum.

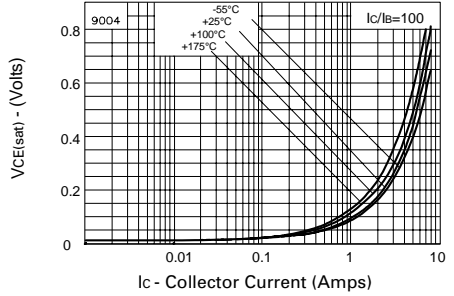


# ZTX688B

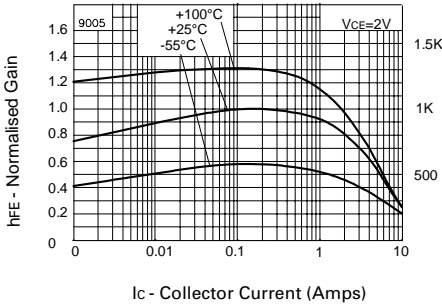
## TYPICAL CHARACTERISTICS



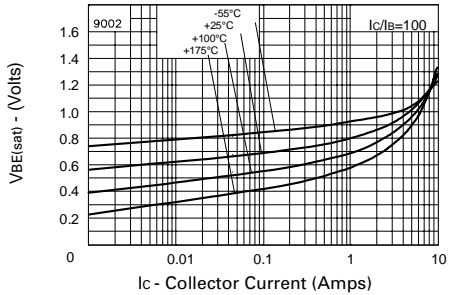
**VCE(sat) v IC**



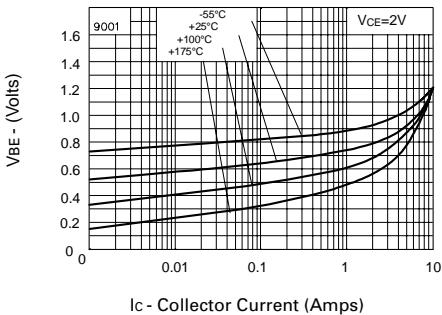
**VCE(sat) v IC**



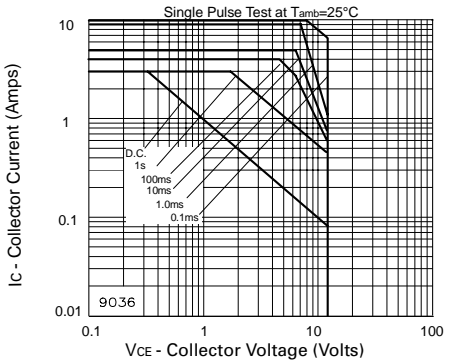
**hFE v IC**



**VBE(sat) v IC**



**VBE(on) v IC**



**Safe Operating Area**



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331